

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОКБ «ИСКРА»



ОАО «ОКБ «Искра»

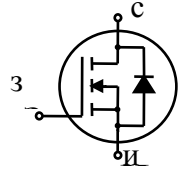
2П829Е9

Uси макс = 60 В

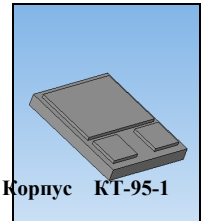
Iс макс = 60 А

Rси отк = 0,005 Ом

Мощный высоковольтный МДП транзистор в корпусе для поверхностного монтажа



Стойкость к воздействию
спец. факторов- 2Ус



Максимальные параметры

Обознач.	Наименование параметра	Значение	Ед. изм.
Uси макс	Макс. напряжение сток-исток	60	В
Uзи макс	Макс. напряжение затвор-исток	±25	В
Iс макс	Макс. ток стока	60	А
Iс и макс	Макс. импульсный ток стока	180	А
Rмакс	Макс. допуст. пост. мощность	125	Вт
Tпер макс	Макс. допуст. температура перех.	150	°С
Траб corp	Рабочая температура корпуса	- 60 до 125	°С

Электрические характеристики при Tпер = 25 °С

Обозн.	Название параметра	Значение параметра			Един. измер.	Режим измерения
		Не менее	Тип.	Не более		
Iс нач	Начальный ток стока			0,5	мА	Uси = 60 Uзи = 0 В
Iз ут	Ток утечки затвора			100	нА	Uзи = ±20 В
Rси отк	Сопротивление сток-исток в откр. состоянии			0,005	Ом	Uзи = 15 В, Iс = 30А
Uпор	Пороговое напряжение	2,0		4,0	В	Uзи = Uси = 10 В, Iс = 10 мА
S	Крутизна		40			Uси ≥ 15 В, Iс = 30 А
Qз			193		нКл	Uси = 30 В, Iс = 30А
Qзи			48		нКл	Uзи = 13 В
Qзс			73		нКл	
tз вкл			48		нс	Uси = 30 В, Iс = 30 А, Uзи = 10 В, Rз = 2 Ом
tнар			540		нс	
tз выкл			144		нс	
tсп			72		нс	
Rз	Вход. сопротив. затвора		1		Ом	
Cвх	Входная емкость		11500		пФ	Uси = 25В, Uзи = 0 В f = 1МГц
Cвых	Выходная емкость		3200		пФ	
Cпрох	Проходная емкость		800		пФ	

Электрические параметры встроенного диода

Обозн.	Название параметра	Значение параметра			Един. измер.	Режим измерения
		Не менее	Тип.	Не более		
Iд	Прям. ток диода		60		А	
Uпр д	Прям. напряжение диода		0,85		В	Iс = 30 А
tобр вос			240		нс	dI/dt = 1А/мкс, Iд = 1А
Qобр вос			0,115		мКл	dI/dt = 1А/мкс, Iд = 1А

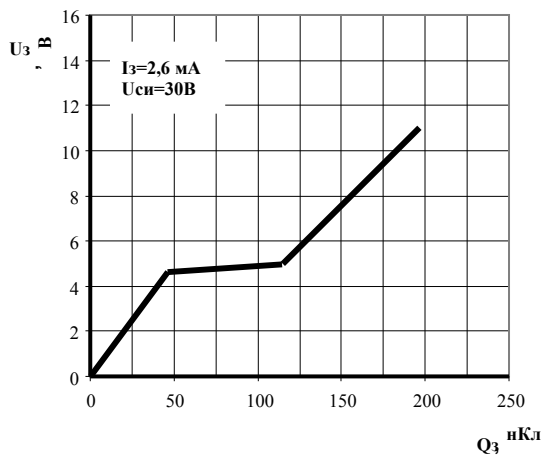


Рисунок 1 - Зависимость заряда затвора Q_3 от напряжения затвора U_3 для транзистора типа 2П829Е9

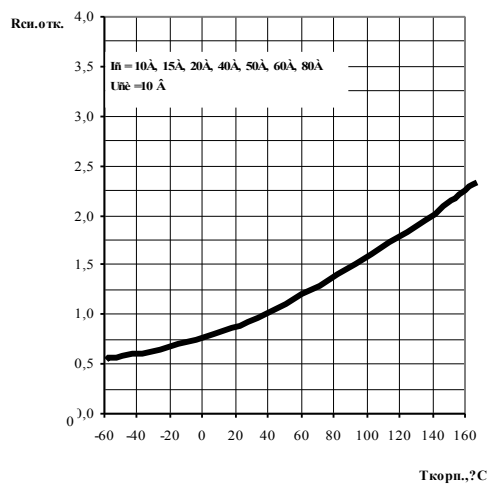


Рисунок 4 - Зависимость нормализованного сопротивления сток-исток в открытом состоянии $R_{си.отк.}$ от температуры корпуса $T_{корп.}$ транзисторов 2П829Е9

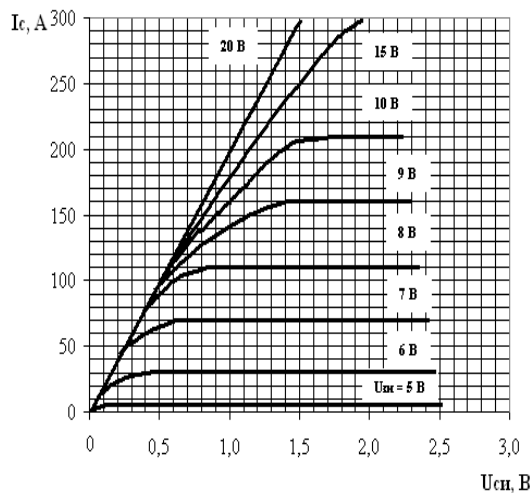


Рисунок 2 - Зависимость тока стока I_c от напряжения сток-исток $U_{си}$ транзисторов 2П829Е9

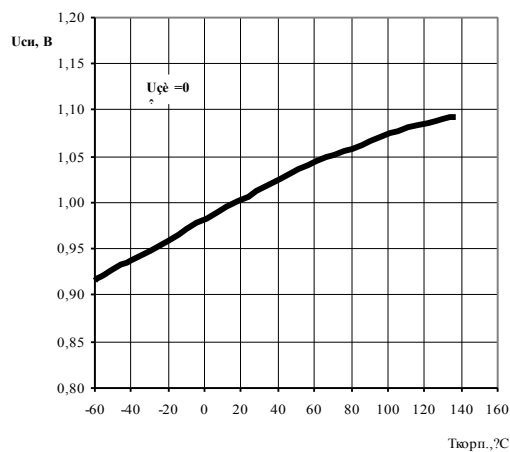


Рисунок 5 - Зависимость нормализованного напряжения сток-исток $U_{си}$ от температуры корпуса $T_{корп.}$ транзисторов 2П829Е9

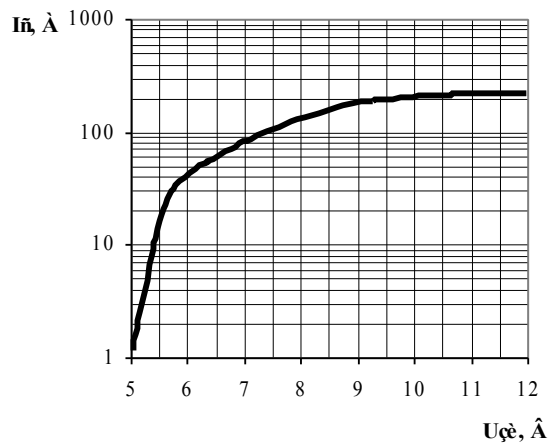


Рисунок 3 - Зависимость тока стока I_c от напряжения затвор-исток $U_{зи}$ транзисторов 2П829Е9

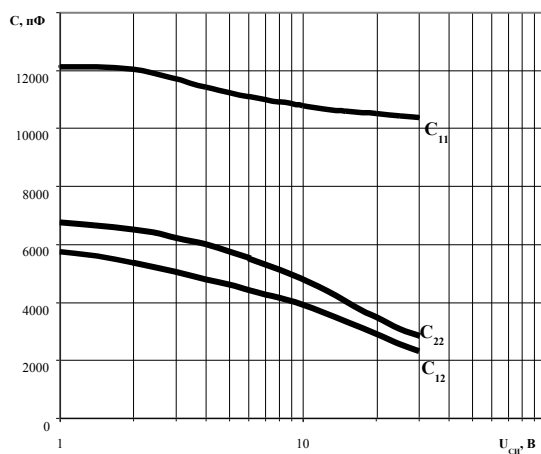


Рисунок 6 - Зависимости входной (C_{11}), выходной (C_{22}) и проходной (C_{12}) емкостей от напряжения сток-исток при температуре корпуса $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ транзисторов 2П829Е9

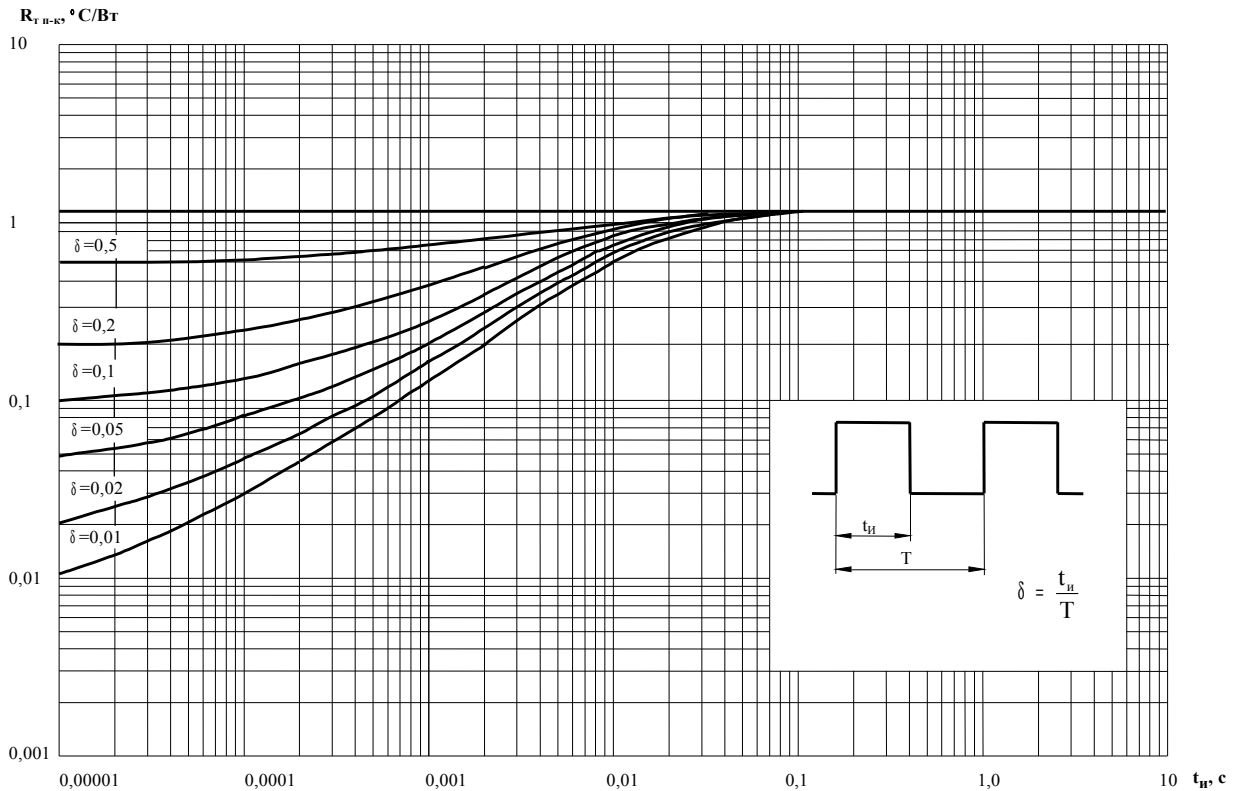
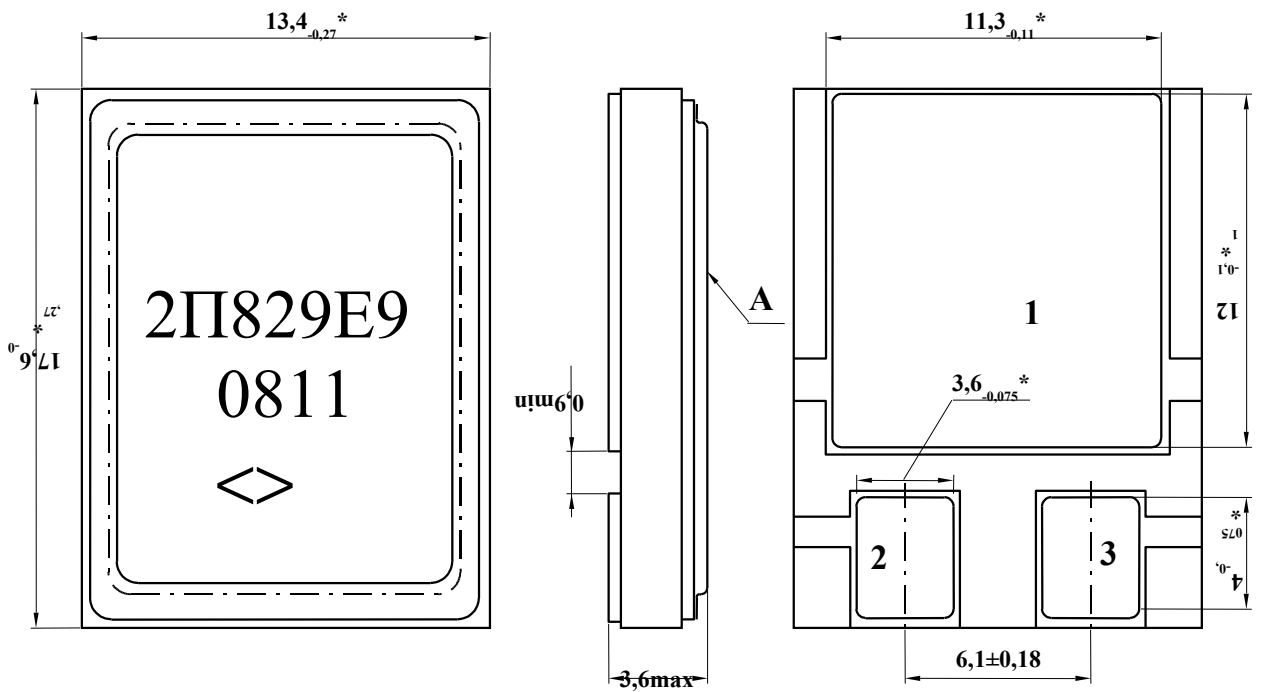


Рисунок 7– Зависимость теплового сопротивления переход-корпус $R_{ТП-К}$ от длительности импульса t_n и скважности импульса δ транзисторов 2П829Е9

Габариты транзистора 2П829Е9 в Корпусе КТ-95-1



Обозначение выводов	Назначение выводов
1	Сток
2	Исток
3	Затвор